

Silicon Power Schottky Diode

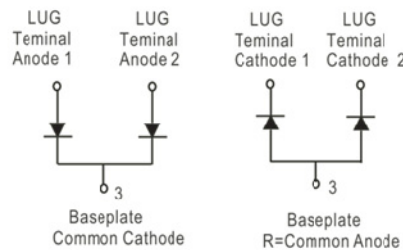
$V_{RRM} = 150\text{ V} - 200\text{ V}$

$I_{F(AV)} = 200\text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types from 150 V to 200 V V_{RRM}
- Not ESD Sensitive

Twin Tower Package



Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MBR200150CT(R)	MBR200200CT(R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		150	200	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		106	141	V
DC blocking voltage	V_{DC}		150	200	V
Operating temperature	T_j		-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-55 to 150	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MBR200150CT(R)	MBR200200CT(R)	Unit
Average forward current (per pkg)	$I_{F(AV)}$	$T_C = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	200	200	A
Peak forward surge current (per leg)	I_{FSM}	$t_p = 8.3\text{ ms}$, half sine	1500	1500	A
Maximum forward voltage (per leg)	V_F	$I_{FM} = 100\text{ A}$, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.88	0.92	V
Reverse current at rated DC blocking voltage (per leg)	I_R	$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	3	3	mA
		$T_j = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	10	10	
		$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	50	50	

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction-case (per leg)	$R_{\theta JC}$		0.45	0.45	$^{\circ}\text{C/W}$
---	-----------------	--	------	------	----------------------

Figure .1- Typical Forward Characteristics

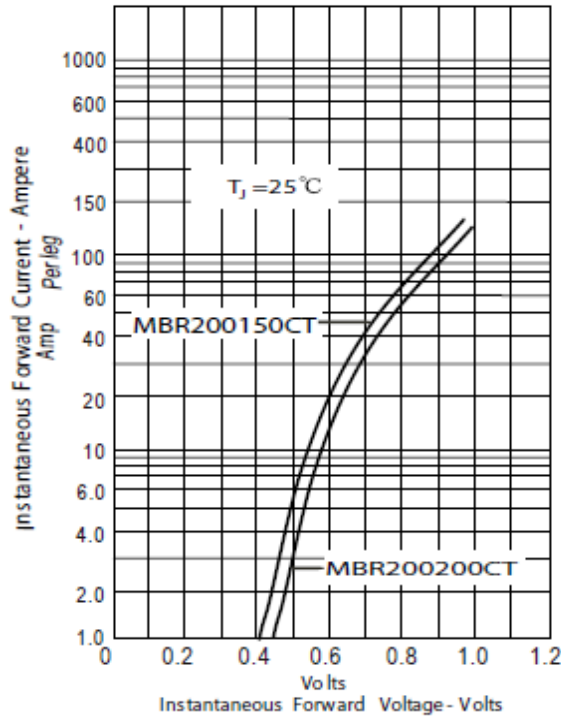


Figure .2- Forward Derating Curve

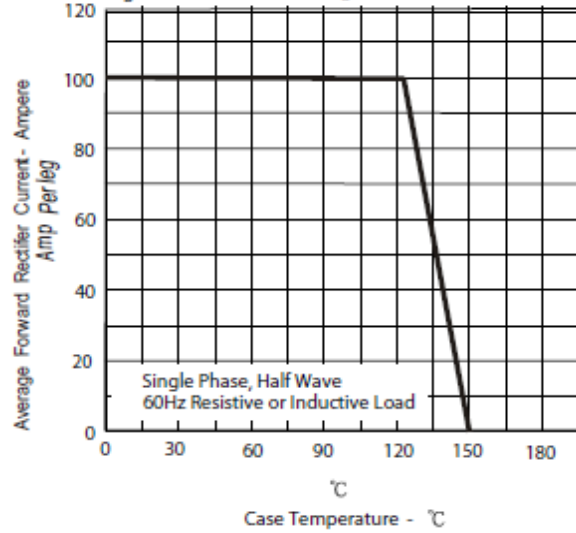


Figure .3- Peak Forward Surge Current

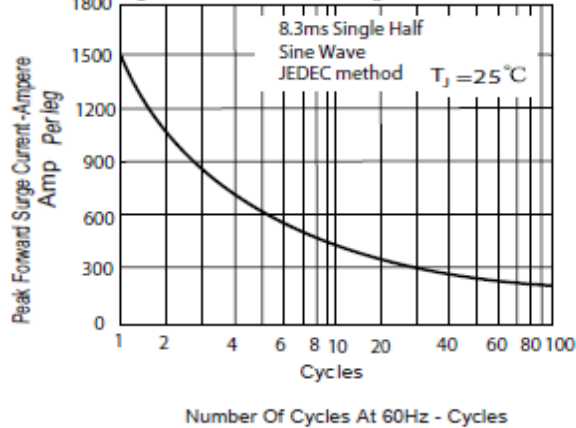
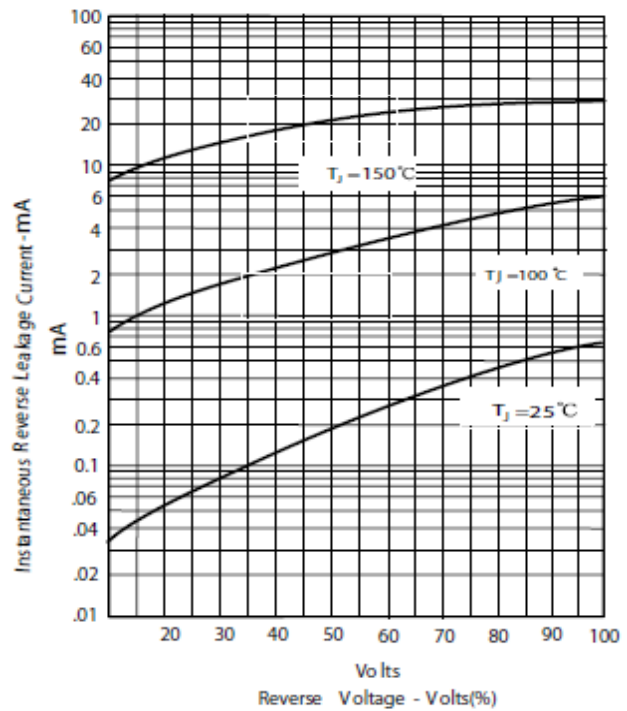
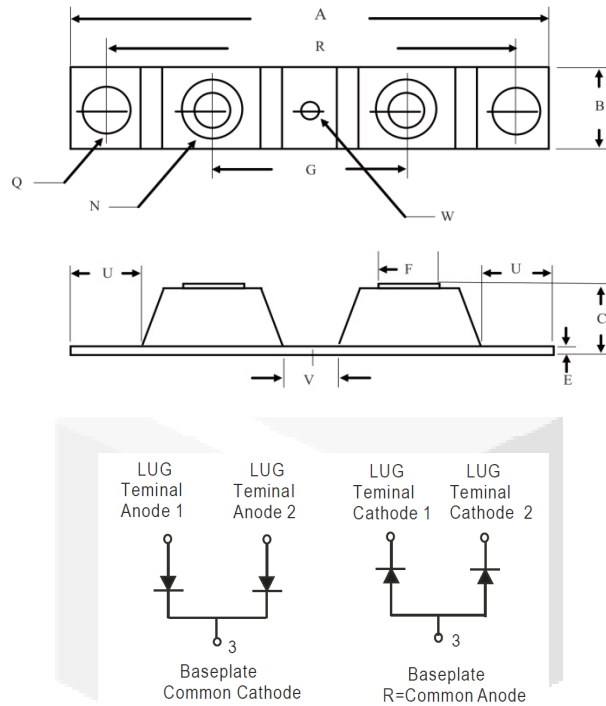


Figure .4- Typical Reverse Characteristics



Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



DIM	Inches		Millimeters	
	Min	Max	Min	Max
A	----	3.630	----	92.40
B	0.700	0.800	17.78	20.32
C	----	0.650	----	16.51
E	0.130	0.141	3.30	3.60
F	0.482	0.490	12.25	12.45
G	1.368	BSC	34.75	BSC
N	1/4-20 UNC FULL			
Q	0.275	0.290	6.99	7.37
R	3.150	BSC	80.01	BSC
U	0.600	----	15.24	----
V	0.312	0.370	7.92	9.40
W	0.180	0.195	4.57	4.95

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[MBR200200CTR](#) [MBR200150CTR](#) [MBR200200CT](#) [MBR200150CT](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9